

О ДИНАМИЧЕСКОМ ТОРМОЖЕНИИ ИЗГИБНЫХ КОРОТКОВОЛНОВЫХ КОЛЕБАНИЙ ДИСЛОКАЦИЙ

Батаронов И.Л., Дежин В.В.

Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия
viktor.dezhin@mail.ru

В работе исследовались изгибные коротковолновые колебания дислокаций, вызванные внешним воздействием произвольной частоты. Линия дислокации располагалась вдоль оси z . Рассматривались малые колебания дислокаций в диссипативной среде. Для этого случая, используя результаты работы [1], записано выражение мнимой части обратной обобщенной восприимчивости дислокации в диссипативном кристалле:

$$\begin{aligned}
 \text{Im } g^{-1}(k_z, \omega) = & -\frac{\mu b_s^2}{2\pi} \omega \int_{|k_z|}^{k_m} k dk \left\{ \frac{\gamma_t}{c_l^2 k^2} + \frac{1}{(c_l^2 k^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2 \gamma_l^2} \left(\frac{\omega^4 \gamma_t}{c_l^2 k^2} + \right. \right. \\
 & + 3k_z^2 c_l^2 \gamma_t - \frac{4k_z^4 c_l^2 \gamma_t}{k^2} + \frac{12k_z^2 \omega^2 \gamma_t^3}{c_l^2 k^4} - \frac{16k_z^4 \omega^2 \gamma_t^3}{c_l^2 k^6} - \frac{6k_z^2 \omega^2 \gamma_t}{k^2} + \left. \frac{8k_z^4 \omega^2 \gamma_t}{k^4} \right) + \\
 & + \frac{1}{(c_l^2 k^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2 \gamma_l^2} \left(4k_z^2 c_l^2 \gamma_l - \frac{4k_z^4 c_l^2 \gamma_l}{k^2} - \frac{16k_z^2 \omega^2 \gamma_l^2 \gamma_l}{c_l^2 k^4} + \right. \\
 & \left. + \frac{16k_z^4 \omega^2 \gamma_l^2 \gamma_l}{c_l^2 k^6} - 8k_z^2 c_l^2 \gamma_l + \frac{8k_z^2 \omega^2 \gamma_l}{k^2} + \frac{8k_z^4 c_l^2 \gamma_l}{k^2} - \frac{8k_z^4 \omega^2 \gamma_l}{k^4} \right) \left. \right\} - \\
 & - \frac{\mu b_e^2}{2\pi} \omega \int_{|k_z|}^{k_m} k dk \left\{ \frac{\gamma_t}{c_l^2 k^2} - \frac{2\gamma_t}{c_l^2 k^2} + \frac{c_l^2 \gamma_l}{c_l^4 k^2} + \frac{\omega^2 \gamma_l^2}{(c_l^2 k^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2 \gamma_l^2} \left(\frac{\omega^2}{c_l^2 k^2 \gamma_t} + \right. \right. \\
 & + \frac{k_z^4 c_l^2}{k^2 \omega^2 \gamma_t} + \frac{4k_z^4 \gamma_t}{c_l^2 k^6} - \left. \frac{2k_z^4}{k^4 \gamma_t} \right) + \frac{\omega^2 \gamma_l^2}{(c_l^2 k^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2 \gamma_l^2} \left(\frac{2c_l^2}{c_l^2 \gamma_l} - \frac{c_l^2 \omega^2}{c_l^4 k^2 \gamma_l} - \right. \\
 & - \frac{4c_l^2 \gamma_l}{c_l^4 k^2} - \frac{2c_l^2 k_z^2}{\omega^2 \gamma_l} + \frac{k_z^4 c_l^2}{k^2 \omega^2 \gamma_l} + \frac{8k_z^2 \gamma_t^2}{c_l^2 k^4 \gamma_l} - \frac{4\gamma_t^2}{c_l^2 k^2 \gamma_l} - \frac{4k_z^4 \gamma_t^2}{c_l^2 k^6 \gamma_l} - \frac{2\gamma_t}{\gamma_l^2} + \\
 & \left. \left. + \frac{2\omega^2 \gamma_t}{c_l^2 k^2 \gamma_l^2} + \frac{4k_z^2 c_l^2 \gamma_t}{\omega^2 \gamma_l^2} - \frac{4k_z^2 \gamma_t}{k^2 \gamma_l^2} + \frac{8\gamma_t}{c_l^2 k^2} - \frac{2k_z^4 c_l^2 \gamma_t}{k^2 \omega^2 \gamma_l^2} + \frac{2k_z^4 \gamma_t}{k^4 \gamma_l^2} \right) \right\}. \quad (1)
 \end{aligned}$$

Здесь μ – модуль сдвига кристалла, b_s и b_e – винтовая и краевая компоненты вектора Бюргера дислокации, k – волновое число, k_z – компонента волнового вектора вдоль линии дислокации, k_m – максимальное волновое число, $\gamma_t(k)$ и $\gamma_l(k)$ – коэффициенты затухания поперечных и продольных звуковых волн в диссипативной среде, c_t и c_l – скорости поперечных и продольных звуковых волн в бездиссипативном кристалле, ω – частота. Проведена оценка записанных интегралов для механизма электронного торможения дислокаций. Тогда в рассматриваемом коротковолновом случае ($1 \ll |k_z l| \ll k_m l$) коэф-

коэффициенты затухания $\gamma_t(x) = \frac{4}{3\pi}\gamma_0x$ и $\gamma_l(x) = \frac{\pi}{6}\gamma_0x$ [2], где l – длина свободного пробега электрона, $x = kl$ – безразмерная переменная, γ_0 – константа, зависящая от материала. Учет главных по k членов в выражении (1) приводит к необходимости вычисления интегралов

$$\int_{|k_z l|}^{k_m l} dx, \quad \int_{|k_z l|}^{k_m l} \frac{x^2 dx}{\left(x^2 - \frac{l^2 \omega^2}{c_t^2}\right)^2 + \frac{64l^4 \omega^2 \gamma_0^2}{9\pi^2 c_t^4} x^2}, \quad \int_{|k_z l|}^{k_m l} \frac{x^2 dx}{\left(x^2 - \frac{l^2 \omega^2}{c_t^2}\right)^2 + \frac{\pi^2 l^4 \omega^2 \gamma_0^2}{9c_t^4} x^2}. \quad (2)$$

Первый интеграл в (2) соответствует торможению прямолинейной дислокации и дает следующий вклад в мнимую часть обратной обобщенной восприимчивости дислокации:

$$-\omega B_s - \omega B_e = -\frac{2}{3\pi} \frac{\mu b_s^2}{c_t^2} \omega \gamma_0(k_m l) - \frac{1}{2\pi} \frac{\mu b_e^2}{c_t^2} \omega \gamma_0 \left(\frac{3}{4\pi} - \frac{8}{3\pi} \frac{c_t^2}{c_l^2} + \frac{\pi}{6} \frac{c_t^2}{c_l^2} \right) (k_m l). \quad (3)$$

Второй и третий интегралы в (2) дают вклад в мнимую часть обратной обобщенной восприимчивости дислокации, соответствующий дополнительной диссипации энергии за счет изгибных колебаний дислокации:

$$-\frac{3}{4\pi} b_s^2 \frac{\mu(k_z l)^2}{l^2} \operatorname{arctg} \frac{8l^2 \omega \gamma_0}{3\pi c_t^2 |k_z l|} + \left(\frac{16}{\pi^3} - \frac{1}{\pi} \frac{c_t^2}{c_l^2} \right) b_s^2 \frac{\mu(k_z l)^2}{l^2} \operatorname{arctg} \frac{\pi l^2 \omega \gamma_0}{3c_t^2 |k_z l|} - \left(\frac{8}{\pi^3} - \frac{1}{2\pi} \frac{c_t^2}{c_l^2} \right) b_e^2 \frac{\mu(k_z l)^2}{l^2} \operatorname{arctg} \frac{\pi l^2 \omega \gamma_0}{3c_t^2 |k_z l|}. \quad (4)$$

В итоге для мнимой части обратной обобщенной восприимчивости дислокации в диссипативном кристалле получено:

$$\operatorname{Im} g^{-1}(k_z, \omega) = -\frac{2}{3\pi} \rho b_s^2 \omega \gamma_0(k_m l) - \frac{1}{2\pi} \left(\frac{3}{4\pi} - \frac{8}{3\pi} \frac{c_t^2}{c_l^2} + \frac{\pi}{6} \frac{c_t^2}{c_l^2} \right) \rho b_e^2 \omega \gamma_0(k_m l) - \frac{3}{4\pi} b_s^2 \frac{\mu(k_z l)^2}{l^2} \operatorname{arctg} \frac{8l^2 \omega \gamma_0}{3\pi c_t^2 |k_z l|} + \left(\frac{8}{\pi^3} - \frac{1}{2\pi} \frac{c_t^2}{c_l^2} \right) (2b_s^2 - b_e^2) \frac{\mu(k_z l)^2}{l^2} \operatorname{arctg} \frac{\pi l^2 \omega \gamma_0}{3c_t^2 |k_z l|},$$

где ρ – плотность материала. Заметим, что при малых значениях частоты выражение (4) переходит в

$$-\left(\frac{2}{\pi^2} - \frac{48}{\pi^2} \frac{c_t^2}{c_l^2} + 3 \frac{c_t^4}{c_l^4} \right) \rho b_s^2 \omega \gamma_0 |k_z l| - 3 \left(\frac{8}{\pi^2} - \frac{1}{2} \frac{c_t^2}{c_l^2} \right) \frac{c_t^2}{c_l^2} \rho b_e^2 \omega \gamma_0 |k_z l|.$$

Этот результат с точностью до коэффициента совпадает с предельным результатом, полученным в работе [1].

Список литературы

1. Рошупкин, А.М. Обобщенная восприимчивость дислокации в диссипативном кристалле [Текст] / А.М. Рошупкин, И.Л. Батаронов, В.В. Дежин // Изв. РАН. Сер. Физическая. 1995. Т. 59, № 10. С. 12-16.
2. Киттель Ч. Квантовая теория твердых тел [Текст] / Чарльз Киттель; перевод с англ. А.А. Гусева. – М.: Наука, 1967. 492 с.